	<h2 style="color: red;">SI6463BDQ-T1-E3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI6463BDQ-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI6463BDQ-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 12047 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI6463BDQ-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	12047 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 7.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.05W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta)

SI6463BDQ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6463BDQ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6463BDQ-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6463BDQ-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6463BDQ V SI6463BDQ V</p>	 <p>SI6459DQ-T1-E3 VISHAY VISHAY TSOP-8</p>	 <p>SI6459DQ-T1 VISHAY VISHAY SSOP-8</p>	 <p>SI6463BDQ. VIS SI6463BDQ. VIS</p>
 <p>SI6463BDQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6463BDQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6463BDQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6463DQ SI SI6463DQ SI</p>

SI6463BDQ-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI6463BDQ-T1-E3	Vishay / Siliconix	SI6463BDQ-T1-E3 Datenblatt	SI6463BDQ-T1-E3-Datenblätter	SI6463BDQ-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI6463BDQ-T1-E3
SI6463BDQ-T1-E3 Electronic		SI6463BDQ-T1-E3-Komponenten	SI6463BDQ-T1-E3-Verteiler	SI6463BDQ-T1-E3-Bild	SI6463BDQ-T1-E3-Teil
SI6463BDQ-T1-E3 Preis		SI6463BDQ-T1-E3 Hersteller	SI6463BDQ-T1-E3 Bild	SI6463BDQ-T1-E3 Aktie	SI6463BDQ-T1-E3 Inventar
SI6463BDQ-T1-E3 Neu		SI6463BDQ-T1-E3 Original	SI6463BDQ-T1-E3 garantiert	SI6463BDQ-T1-E3 RFQ	SI6463BDQ-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited